

SM2097EH

特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术
- ◆ 支持输入电压: 120Vac/220Vac
- ◆ 芯片间输出电流偏差<±5%
- ◆ 700V 高压 MOS 管, 无需任何保护器 件可通过 600V 雷击
- ◆ PF>0.95 THD<20%
- ◆ 输入线电压补偿
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 芯片可与 LED 共用 PCB 板
- ◆ 封装形式: ESOP8

应用领域

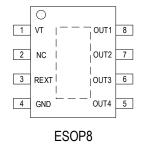
- ◆ LED 球泡灯,筒灯
- ◆ LED 光源

概述

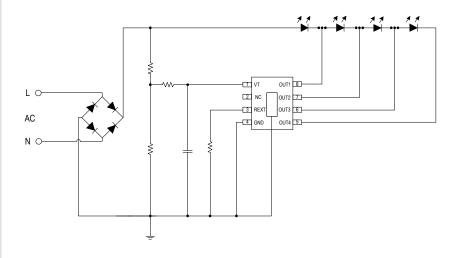
SM2097EH 是一款 4 段低 THD、高功率因数 LED 线性恒流控制芯片,芯片集成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术,具有优越的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可通过600V 雷击浪涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时 SM2097EH 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时,SM2097EH 将通过外置的补偿电阻,减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。

其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。

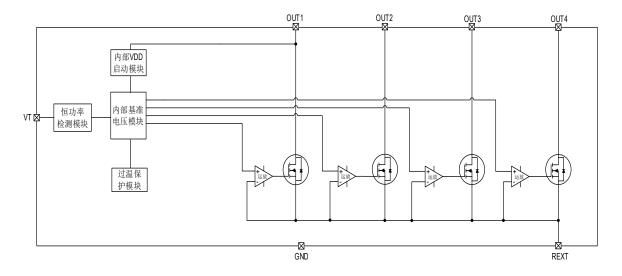
管脚图



典型应用



内部功能框图



管脚说明

管脚序号	管脚名称	管脚说明	
1	VT	电压采样端口	
2	NC	悬空脚	
3	REXT	输出电流值设置端口	
4	GND	芯片地	
5	OUT4	恒流输出端口 4	
6	OUT3	恒流输出端口 3	
7	OUT2	恒流输出端口 2	
8	OUT1	电源输入与恒流输出端口1	
衬底	NC	应用时衬底接 GND	

订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸	
り购至5 到表形式		管装	编带		
SM2097EH	ESOP8	100000 只/箱	4000 只/盘	13寸	



极限参数 (注1)

若无特殊说明, TA=25°C。

符号	说明	范围	单位
Vouт	OUT 端口电压	-0.5~700	V
VT	VT 端口电压	-0.5~8	V
V _{REXT}	REXT 端口电压	-0.5~8	V
RθJA	PN 结到环境的热阻(注 2)	65	°C/W
PD	功耗 (注3)	1.25	W
TJ	工作结温范围	-40~150	°C
Tstg	存储温度	-55~150	°C
V _{ESD}	HBM 人体放电模式	2	KV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。

电气工作参数(注4、5)

若无特殊说明, TA=25°C。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IN_BV}	VIN 端口电压	-	700	-	-	V
V _{OUT_BV}	OUT 端口耐压	-	700	-	-	V
l _{DD}	静态电流	V _{IN} =20V	208	260	312	uA
V _{REXT_1}	REXT 端口第一电压	V _{0UT1} =15V, REXT=30Ω	-	550	-	mV
V _{REXT_2}	REXT 端口第二电压	$V_{OUT1}=V_{OUT2}=15V$, REXT= 30Ω	-	695	-	mV
V _{REXT_3}	REXT 端口第三电压	$V_{OUT1}=V_{OUT3}=15V$, REXT= 30Ω	-	865	-	mV
V _{REXT_4}	REXT 端口第四电压	$V_{OUT1}=V_{OUT4}=15V$, REXT= 30Ω	-	940	-	mV
D _{IOUT}	IOUT 片间偏差	Іоит=30mА	-	±5	-	%
Tsc	电流负温度补偿起始点(注6)	-	-	145	-	°C

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。

电子邮件: market@chinaasic.com 网址: <u>www.chinaasic.com</u> Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

注 2: R θ JA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T_{JMAX} , $R\theta JA$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_D = (T_{JMAX}-T_A)/R\theta JA$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。



功能表述

SM2097EH 是一款四通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,内部集成 LED 恒流控制模块、OUT 端口高压驱动模块等功能模块,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片具有高功率因数和低谐波。芯片集成了线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。

◆ 输出电流

SM2097EH 芯片具有 4 个电流驱动端口,每个端口输出电流通过外置电阻 R 进行调节,lour=V_{REXT}/R, 4 级开关逐级开启。

系统输出电流等于在各个端口电流对应占空比值的叠加后的平均值。

◆ 输出 LED 灯珠压降及各段灯珠比例设计

SM2097EH 芯片各 OUT 端口灯珠压降比例依次为 7:4:2:1 时,系统获得较佳的光效和较高的功率因素,如果想获得更高的光效,可适当调整各段灯珠比例,如调整 OUT1 或 OUT2 端口 LED 灯珠压降的比例值。

◆ 输入线电压补偿

SM2097EH 通过 VT 端口检测输入电压的变化,当输入电压升高时,减小输入电流;当输入电压降低时,增大输入电流,故可使系统输入功率不随输入线网电压的波动而变化,基本保持恒定。

◆ 芯片散热处理

SM2097EH 芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需采用良好的散热处理,确保芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:

- 1) 系统采用铝基板;
- 2) 增大 SM2097EH 衬底的覆铜面积;
- 3) 增大整个灯具的散热底座

若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 SM2097EH 芯片并联使用。

◆ 过温调节功能

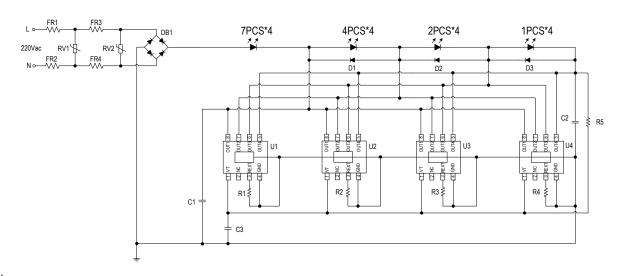
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2097EH 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 145℃ 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。



典型应用方案

◆ 方案一

SM2097EH 投光灯应用方案 (50W)



BOM 单

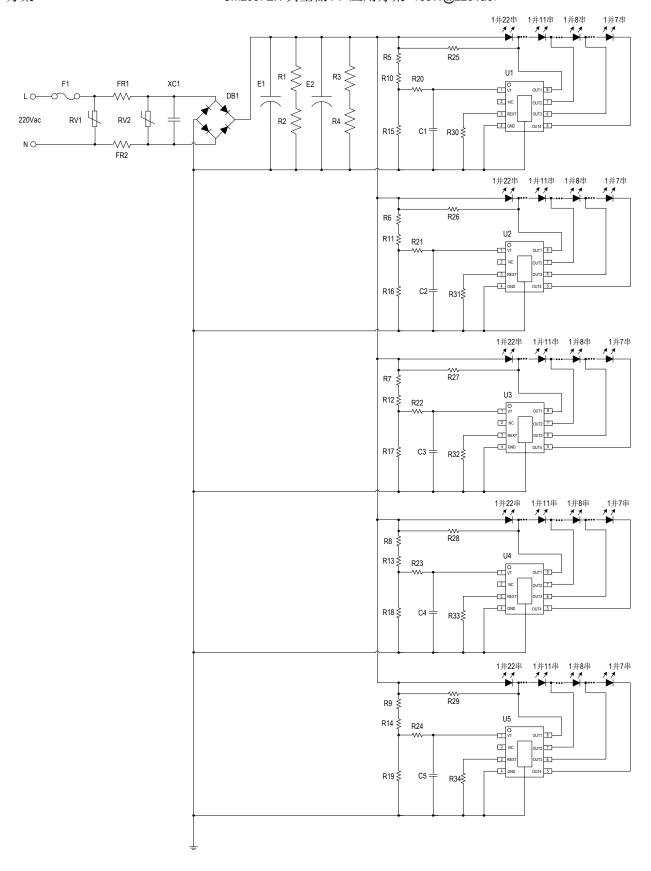
·			
位号	参数	位号	参数
FR1、FR2、FR3、FR4	10R/1W 绕线电阻	D1、D2、D3	E1J
DB1	MB6S	C1、C2	10nF/1KV
RV1、RV2	贴片 10D471	C3	4.7uF/16V
R1、R2、R3、R4	11R/0805	U1、U2、U3、U4	SM2097EH
R5	82K/1206	LED1~LED56	18V/60mA

- 1. LED 灯串电压建议控制在 240V 到 260V 之间, 系统工作最优化;
- 2. 通过改变 R1~R4 电阻值,调整输出工作电流值;
- 3. R5 为系统 VT 脚检测电阻,建议取值 82K~160K,根据方案恒功率效果而定;
- 4. C3 为 VT 端口滤波电容, 建议取值 4.7uF~10uF;
- 5. 为提高系统可靠性, FR1~FR4、RV1~RV2、C1~C2、D1~D3 建议保留。



◆ 方案二

SM2097EH 典型低 PF 应用方案(85W@220Vac)





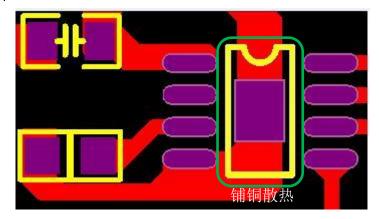
BOM 单

位号	参数	位号	参数
F1	3.15A/350V	R15、R16、R17、R18、R19	62K/0805
FR1、FR2	2.2R/3W 绕线电阻	R20、R21、R22、R23、R24	100K/0805
DB1	GBU8M	R25、R26、R27、R28、R29	100K/1206
RV1、RV2	14D471	R30、R31、R32、R33、R34	10R/0805
X 电容	0.1uF/310V	E1、E2	100uF/400V
R1、R2、R3、R4	510K/1206	C1、C2、C3、C4、C5	1.0uF/16V
R5、R6、R7、R8、R9	430K/1206	U1、U2、U3、U4、U5	SM2097EH
			6V/150mA
R10、R11、R12、R13、R14	270K/1206	LED1∼LED240	注:每单个系统第一段和第
		LEDT SLED240	三段有 2PCS,植物灯珠
			1.75V/150mA

备注:

- 1. LED 灯串电压建议在 250~270V, 系统工作最优化。
- 2. 通过改变 R30、R31、R32、R33、R34 电阻值,调整输出工作电流值。
- 3. R5~R9、R10~R14、R15~R19 为系统 VT 脚检测电阻, R5~R9 取值为 430K、R10~R14 取值 270K, R15~R19 根据方案恒功率效果而定。
- 4. R20~R24 和 C1~C5 是为 VT 脚滤波器件,R20~R24 建议取值 100K,C1~C5 建议取值 1uF。
- 5. 建议保留保险丝(或绕线电阻)和压敏电阻,以提高抗雷击能力。

PCB layout 注意事项



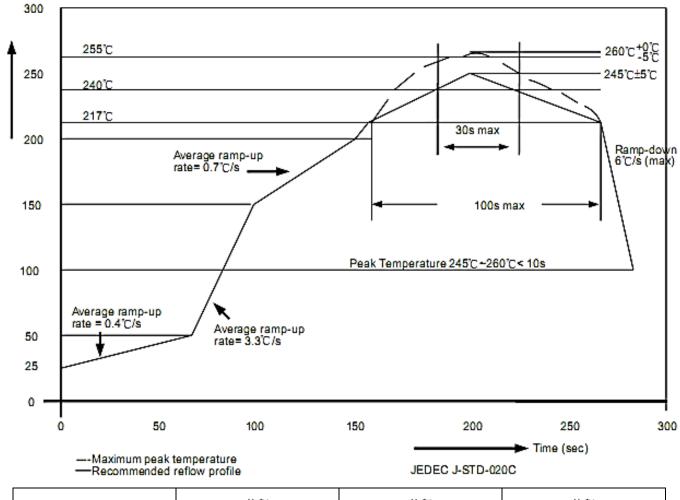
- (1) IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺,保证 IC 衬底与 PCB 接触良好,IC 衬底禁止使用红胶工艺。
- (2) 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关,实际应用功率需匹配散热条件。
- (3) IC 衬底部分进行铺铜处理,进行散热,增加可靠性,铺铜如上图所示,建议衬底焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。
- (4) IC 衬底焊盘漏铜距离 OUT 端口需保证 0.8mm 以上的间距。



封装焊接制程

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准,封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

Temperature (°C)

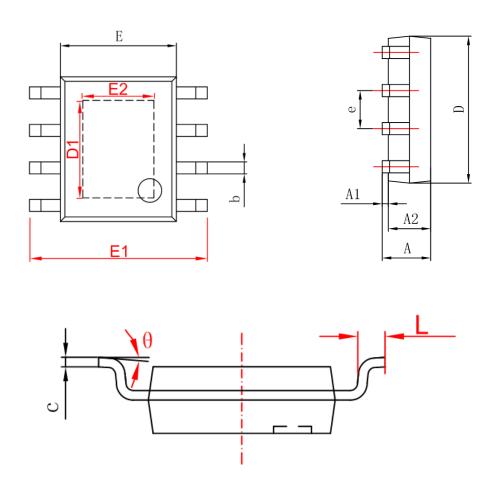


封装厚度	体积 mm³< 350	体积 mm³: 350~2000	体积 mm³≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C



封装形式

ESOP8



Symbol	Min(mm)	Max(mm)	
A	1.25	1.95	
A1	-	0.1	
A2	1.25	1.75	
b	0.25	0.7	
С	0.1	0.35	
D	4.6	5.3	
D1	3.12(REF)		
E	3.7	4.2	
E1	5.7	6.4	
E2	2.34(REF)		
е	1.270(BSC)		
L	0.2	1.5	
Θ	0°	10°	

电子邮件: market@chinaasic.com

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

网址: www.chinaasic.com

注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准



使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利,客户在 进行产品购买前,建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息,所有技术应用需要严格按照最新产品说明 书进行设计。

明微电子的产品,除非经过明微合法授权,否则不应使用于医疗或军事行为上,若使用者因此导致任何身体伤 害或生命威胁甚至死亡,明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权,任何个人和组织不 得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为,本企 业将立即全面启动法律程序, 追究法律责任。